

# 1 Grundlagen

## 1.1 Dotieren

### 1.1.1 Dotieren

Dotieren bedeutet das Einbringen von Fremdatomen in einen Halbleiterkristall zur gezielten Veränderung der Leitfähigkeit. Zwei der wichtigsten Stoffe, mit denen Silicium dotiert werden kann, sind Bor (3 Valenzelektronen = 3-wertig) und Phosphor (5 Valenzelektronen = 5-wertig). Weitere sind: Aluminium, Indium (3-wertig) und Arsen, Antimon (5-wertig).

Die Dotierelemente werden in die Gitterstruktur des Halbleiterkristalls eingebaut, die Anzahl der Außenelektronen bestimmt die Art der Dotierung. Elemente mit 3 Valenzelektronen werden zur p-Dotierung benutzt, 5-wertige Elemente zur n-Dotierung. Die Leitfähigkeit eines gezielt verunreinigten Siliciumkristalls kann so um den Faktor  $10^6$  erhöht werden.

### 1.1.2 n-Dotierung

Das 5-wertige Dotierelement besitzt ein Außenelektron mehr als die Siliciumatome. Vier Außenelektronen verbinden sich mit je einem Siliciumatom, das fünfte ist frei beweglich und dient als Ladungsträger. Dieses freie Elektron benötigt sehr viel weniger Energie um vom Valenzband in das Leitungsband gehoben zu werden, als die Elektronen, die die Eigenleitfähigkeit des Siliciums verursachen. Das Dotierelement, welches ein Elektron abgibt, wird als Elektronendonator (donare, lat. = geben) bezeichnet.

Die Dotierelemente werden durch die Abgabe negativer Ladungsträger positiv geladen und sind fest im Gitter eingebaut, es bewegen sich nur die Elektronen. Dotierte Halbleitmetalle, deren Leitfähigkeit auf freien (negativen) Elektronen beruht sind n-leitend bzw. n-dotiert. Auf Grund der höheren Anzahl der freien Elektronen werden

diese auch als Majoritätsladungsträger bezeichnet, freie bewegliche Löcher dagegen als Minoritätsladungsträger.

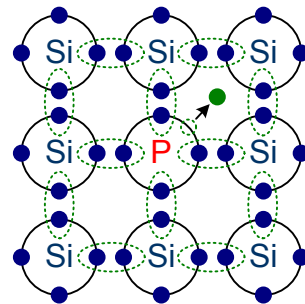


Abb. 1.1: Das Phosphor-Atom gibt sein 5. Elektron ab, das keine Bindung eingehen kann. Es dient als freier Ladungsträger.

Arsen wird als Alternative zu Phosphor verwendet, da dessen Diffusionskoeffizient geringer ist. Das bedeutet, dass der Dotierstoff bei späteren Prozessschritten weniger stark diffundiert und die Dotierung somit an der Stelle bleibt, wo sie eingebracht wurde.

### 1.1.3 p-Dotierung

Im Gegensatz zum freien Elektron bei der Dotierung mit Phosphor bewirken 3-wertige Dotierelemente genau das Gegenteil. Sie können ein zusätzliches Außenelektron aufnehmen und hinterlassen so ein Loch im Valenzband der Siliciumatome. Dadurch werden die Elektronen im Valenzband beweglich. Die Löcher bewegen sich in entgegengesetzter Richtung zur Elektronenbewegung. Die dazu nötige Energie beträgt bei Indium als Dotierelement nur 1 % der Energie die nötig ist, um die Valenzelektronen der Siliciumatome in das Leitungsband zu heben.

Durch die Aufnahme eines Elektrons wird das Dotierelement einfach negativ geladen; solche Dotieratome nennt man Elektronenakzeptor (acceptare, lat. = aufnehmen). Auch hier ist das Dotierelement fest im Kristallgitter eingebaut, es bewegt sich nur die positive Ladung. P-leitend oder p-dotiert nennt man diese Halbleiter weil die Leitfähigkeit auf positiven Löchern beruht. Analog zu n-dotierten Halbleitern, sind hier die Löcher die Majoritätsladungsträger, freie Elektronen die Minoritätsladungsträger.

Nach außen sind dotierte Halbleiter elektrisch neutral. Die Bezeichnungen n- bzw. p-Dotierung beziehen sich nur auf die Majoritätsladungsträger.

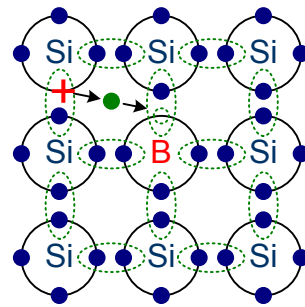


Abb. 1.2: Die freie Stelle am Bor-Atom wird von anderen Elektronen aufgefüllt. Dabei entstehen an anderer Stelle neue Löcher. Diese Leerstellen wandern scheinbar entgegengesetzt zum Elektronenfluss

N- und p-dotierte Halbleiter verhalten sich in Bezug auf den Stromfluss annähernd gleich. Mit steigender Anzahl an Dotierelementen nimmt auch die Zahl von Ladungsträgern im Halbleiterkristall zu. Dabei genügt schon eine sehr geringe Menge an Dotierelementen. Schwach dotierte Siliciumkristalle enthalten nur 1 Fremdatom pro  $10^9$  Siliciumatome, bei den höchsten Dotierungen ist das Verhältnis von Fremdatomen zu Siliciumatomen z.B. 1 zu 1000.

#### 1.1.4 Bänderschema bei dotierten Halbleitern

Bei n-dotierten Halbleitern steht durch das Einbringen eines Dotierelements mit fünf Außenelektronen ein Elektron im Kristall zur Verfügung das nicht gebunden ist, und so mit vergleichsweise geringer Energie in das Leitungsband gehoben werden kann. Somit findet man in n-dotierten Halbleitern ein Donatorniveau nahe der Leitungsbandkante, die zu überwindende Bandlücke ist sehr klein.

Durch das Einbringen eines 3-wertigen Dotierelements steht bei p-dotierten Halbleitern eine Leerstelle zur Verfügung, die schon mit geringer Energie von einem Elektron aus dem Valenzband besetzt werden kann. Bei p-dotierten Halbleitern befindet sich somit ein Akzeptorniveau nahe der Valenzbandkante.

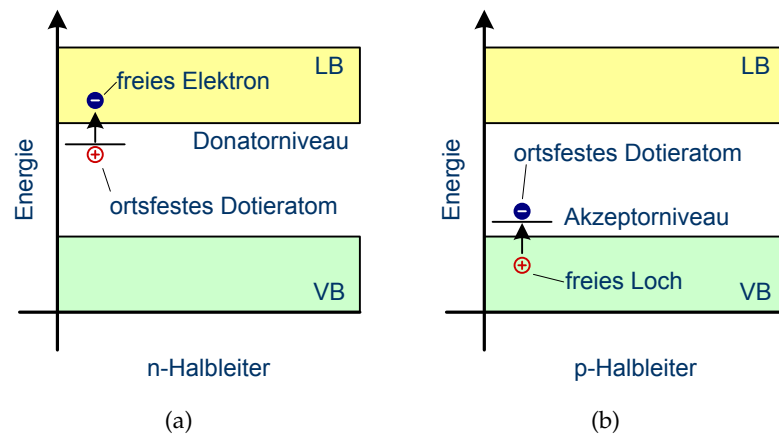


Abb. 1.3: Bändermodell von n- und p-Dotierten Halbleitern